

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2004 年 5 月 13 日 (13.05.2004)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2004/040631 A1

(51) 国際特許分類: H01L 21/205
(21) 国際出願番号: PCT/JP2003/013821
(22) 国際出願日: 2003 年 10 月 29 日 (29.10.2003)
(25) 国際出願の言語: 日本語
(26) 国際公開の言語: 日本語
(30) 優先権データ:
特願 2002-317539
2002 年 10 月 31 日 (31.10.2002) JP
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 三菱重工業株式会社 (MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES)

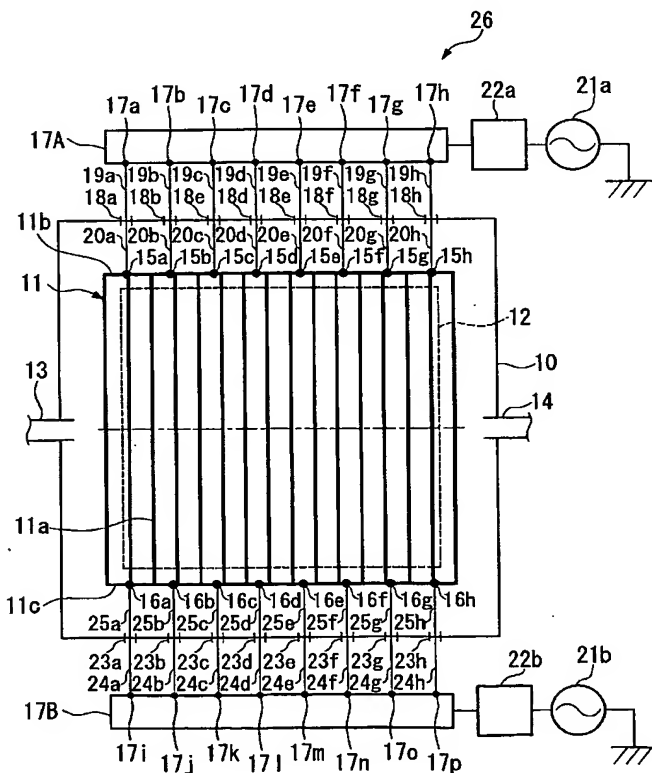
[JP/JP]; 〒108-8215 東京都港区港南二丁目 1 6 番 5 号
Tokyo (JP).

(72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人 (米国についてののみ): 真島 浩 (MASHIMA, Hiroshi) [JP/JP]; 〒851-0392 長崎県 長崎市 深堀町五丁目 7 1 7 番 1 号 三菱重工業株式会社 長崎研究所内 Nagasaki (JP). 山田 明 (YAMADA, Akira) [JP/JP]; 〒851-0392 長崎県 長崎市 深堀町五丁目 7 1 7 番 1 号 三菱重工業株式会社 長崎研究所内 Nagasaki (JP). 川村 啓介 (KAWAMURA, Keisuke) [JP/JP]; 〒851-0392 長崎県 長崎市 深堀町五丁目 7 1 7 番 1 号 三菱重工業株式会社 長崎研究所内

[続葉有]

(54) Title: PLASMA CHEMICAL VAPOR DEPOSITION METHOD AND PLASMA CHEMICAL VAPOR DEPOSITION DEVICE

(54) 発明の名称: プラズマ化学蒸着方法及びプラズマ化学蒸着装置



(57) Abstract: A method of making uniform the distribution characteristics of a film thickness by manipulating the electrical characteristics of a cable transmitting a high-frequency power to restrict the occurrence of a phase difference between high-frequency powers. Coaxial cables (19a-19h and 24a-24h) and vacuum cables (20a-20h, and 25a-25h) having reference lengths are installed, a high-frequency power is actually supplied to form a film on a substrate, and then vapor deposition conditions such as a film thickness are observed. The entire length of coaxial cables, communicating with electrodes and feed points corresponding to portions to be regulated on the substrate, is changed based on the observation result to install them again, and a high-frequency power is supplied as was done in the above operation to form a film. A film formation distribution on the substrate is rendered uniform by repeating the above operation.

(57) 要約: 高周波電力を送送するケーブルの電気的特性を操作することによって、高周波電力間の位相差の発生を抑えて、膜厚の分布特性を均一化する方法を提供する。基準長さを有する同軸ケーブル (19a~19h 及び 24a~24h)、真空ケーブル (20a~20h 及び 25a~25h) を配設し、実際に高周波電力を供給して基板上に製膜させた後、膜厚等の蒸着状態を観察する。観察結果に基づいて、調整すべき基板上の箇所に対応する電極及び給電点に

連通する同軸ケーブルの全長を変化させて再び配設し、先の操作と同様の高周波電力を供給して製膜させる。上記操作を繰り返すことによって、基板

[続葉有]

WO 2004/040631 A1



Nagasaki (JP). 田頭 健二 (TAGASHIRA, Kenji) [JP/JP];
〒851-0392 長崎県 長崎市 深堀町五丁目 7 1 7 番
1号 三菱重工業株式会社 長崎研究所内 Nagasaki (JP).
竹内 良昭 (TAKEUCHI, Yoshiaki) [JP/JP]; 〒850-8610
長崎県 長崎市 飽の浦町 1 番 1 号 三菱重工業株式会
社 長崎造船所内 Nagasaki (JP).

(74) 代理人: 藤田 考晴, 外 (FUJITA, Takaharu et al.); 〒
220-0012 神奈川県 西区 みなとみらい 3-3-1 三菱
重工横浜ビル 2 4 F Kanagawa (JP).

(81) 指定国 (国内): US.

(84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (CH, DE, GB).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される
各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語
のガイダンスノート」を参照。

明 細 書

プラズマ化学蒸着方法及びプラズマ化学蒸着装置

5 技術分野

本発明は、物質を基板に蒸着させるためプラズマを用いて基板上に製膜するプラズマ化学蒸着方法及びプラズマ化学蒸着装置に関する。

背景技術

10 従来、例えば半導体等の物質を基板に蒸着させるプラズマ化学蒸着方法は、真空製膜室を有するプラズマ化学蒸着装置を用いて次のように行われる。

該プラズマ化学蒸着装置は、真空雰囲気配置された基板と、該基板を保持するとともに接地されているアース電極と、該基板と間隔をもって平行に対向配置されたラダー型電極とを備える。このプラズマ化学蒸着装置に前記物質を含む製
15 膜用ガスを導入すると共に、高周波電力給電回路からラダー型電極に給電し、ラダー型電極と基板間にプラズマを発生させる。すると、該プラズマにより前記製膜用ガスが分解されて、前記基板上に物質が蒸着する（例えば、特開 2001-274099 号公報参照。）。

上述のようなプラズマ化学蒸着装置では、例えば、縦方向×横方向の寸法が
20 1 [m] × 1 [m] を超える大面積基板を製膜するような場合、真空製膜室内で生成される膜の膜厚分布を基板全体で均一化するため、前記ラダー型電極と前記基板との間にプラズマを発生させるために印加される高周波電力の電圧分布を前記基板全体において均一化させる対策が施される。例えば、特許文献 1 に示されているように、高周波電力給電回路によって、同一の周波数であって、かつ、
25 一方の高周波電力の位相が他方の高周波電力の位相と異なる前記 2 つの高周波電力を発生させ、ラダー型電極を構成する放電電極に複数のケーブルを介して分配供給する。これによって、膜厚の均一化の妨げとなる放電電極上の定在波の発生を抑制させるとともに、高周波電力給電回路により発生した高周波電力を安定的に供給している。

発明の開示

ところで、上述のようなプラズマ化学蒸着装置では、上述のように、放電電極上の定在波の発生を抑制させる高周波電力を安定的に供給して製膜を図っていても、ラダー型電極に起因する膜厚分布の不均衡が発生する。すなわち、ラダー電極上で、隣接する放電電極部分が左右に存在する基板中央部の放電電極部分と、隣接する放電電極部分が左右のどちらか一方にしか存在しない給電方向と直角の方向の基板端部近傍の放電電極部分とでは、その配置及び構造上、それぞれの放電電極部分が基板に与える影響が異なる。そのため、局所的な膜厚分布の不均衡が発生し、大面積基板における膜厚の分布特性が十分に改善されていないという問題があった。

また、複数の給電点に連通する複数のケーブルのセッティング誤差等の配置に起因する各ケーブル間の電気的特性の均一化が困難となって、ケーブルを伝送される高周波電力に位相差が生じることによる上述と同様の問題があった。

本発明は、上記課題に鑑みてなされたもので、高周波電力を伝送するケーブルの電気的特性を操作することによって、高周波電力間の位相差の発生を抑えて、膜厚の分布特性を均一化する方法を提供することを目的とする。

本発明は、上記課題を解決するため、以下の手段を採用する。

本発明のプラズマ化学蒸着方法は、物質を含む製膜用ガスが導入された真空製膜室内に、放電電極と基板とが対向配置され、高周波電力給電回路により発生した高周波電力を前記真空製膜室の外部に位置する複数の外部ケーブルから、前記真空製膜室の内部に位置するとともに、各前記外部ケーブルに対応する複数の内部ケーブルを介して、前記放電電極に備えられた複数の給電点へ給電し、前記放電電極と前記基板との間にプラズマを発生させて、前記物質を前記基板上に蒸着させるプラズマ化学蒸着方法であって、前記外部ケーブルの電気的特性を変化させて前記複数の給電点へ給電される高周波電力の前記給電点における位相を調整することを特徴とする。

このような方法とすることで、内部ケーブルを含む真空製膜室内部の構成機器の調整作業を伴わずに、高周波電力の複数の給電点における位相の調整作業が実

施できて、作業性が向上する。

すなわち、外部ケーブルの電気的特性を変化させることによって、複数の給電点に給電される高周波電力間の位相差の発生を抑えることができ、発生するプラズマの電圧分布が均一化されて、基板上に生成される薄膜の膜厚分布を均一化することができる。

また、本発明のプラズマ化学蒸着方法は、前記外部ケーブルの電気的特性を変化させて蒸着を行い、前記基板上における前記物質の蒸着状態を観察し、該観察結果に基づきさらに前記外部ケーブルの電気的特性を変化させて、前記複数の給電点へ給電される高周波電力の位相を調整することを特徴とする。

このような方法とすることで、複数の給電点へ高周波電力を供給する複数の外部ケーブルのうち、位相を変化させるべき外部ケーブル及びその電気的特性パラメータが明確にされる。

すなわち、位相を変化させるべき該当ケーブル及びその電気的特性パラメータが特定できるので、複数の給電点に給電される高周波電力間の位相差の発生を抑えることができ、基板上に生成される薄膜の膜厚分布を均一化することができる。

また、本発明のプラズマ化学蒸着方法は、前記外部ケーブルの長さを変化させることによって、前記電気的特性を変化させることを特徴とする。

このような方法とすることで、真空製膜室外部の調整作業によって、高周波電力の複数の給電点における位相の調整作業が実施できて、作業性が向上する。

すなわち、外部ケーブルの長さ寸法を調整することによって、各外部ケーブルを伝送する高周波電力の波長に対応した位相を変更・調整することができ、基板上に生成される薄膜の膜厚分布を均一化することができる。

また、本発明のプラズマ化学蒸着方法は、前記外部ケーブルの長さを1以上のコネクタ脱着によって変化させることを特徴とする。

このような方法とすることで、コネクタ長さ寸法を1つの単位として、ケーブル長さ寸法を変化させることができる。

すなわち、外部ケーブルの長さ寸法の調整を1以上のコネクタの挿入個数を変更することによって行うため、ケーブル自身の長さ寸法を変更させるよりも調整

作業が容易に実施できる。

また、本発明のプラズマ化学蒸着方法は、前記外部ケーブルが導体の周囲に絶縁体を有する構成とされ、該絶縁体の比誘電率を変化させることによって、前記電気的特性を変化させることを特徴とする。

- 5 このような方法とすることで、高周波電力のケーブル間の位相のみならず波長についても調整作業が可能となる。

- すなわち、外部ケーブルが備える絶縁体の材質を調整することによって、ケーブルを伝送する高周波電力の波長が変更可能となり、この波長に対応した位相を変更・調整することができ、基板上に生成される薄膜の膜厚分布を均一化すること
10 ができる。

また、本発明のプラズマ化学蒸着方法は、前記外部ケーブルの絶縁体がポリテトラフルオロエチレンであることを特徴とする。

このような方法とすることで、外部ケーブルの絶縁特性、寸法特性、及び操作性が向上する。

- 15 すなわち、外部ケーブルの絶縁特性、寸法特性、及び操作性が向上して、ケーブルを伝送する高周波電力の位相変更・調整が容易となって、基板上に生成される薄膜の膜厚分布を均一化することができる。

- 本発明のプラズマ化学蒸着方法は、物質を含む製膜用ガスが導入された真空製膜室内に、放電電極と基板とが対向配置され、高周波電力給電回路により発生した高周波電力を前記真空製膜室の外部に位置する外部ケーブルから、前記真空製膜室の内部に位置する内部ケーブルを介して、前記放電電極に備えられた複数の給電点へ給電し、前記放電電極と前記基板との間にプラズマを発生させて、前記物質を前記基板上に蒸着させるプラズマ化学蒸着装置であって、高周波電力の前記複数の給電点における位相差の調整部として前記外部ケーブルの長さを変化させたことを特徴とする。
20 25

このような装置とすることで、外部ケーブルの寸法操作によって、内部ケーブルを含む真空製膜室内部の構成機器の調整作業を伴わずに、高周波電力の複数の給電点における位相の調整ができる。

すなわち、外部ケーブルの操作によって、放電電極に給電される高周波電力の

波長に対応した位相を変更・調整することができ、基板上に生成される薄膜の膜厚分布を均一化することができる。

本発明のプラズマ化学蒸着装置は、物質を含む製膜用ガスが導入された真空製膜室内に、放電電極と基板とが対向配置され、高周波電力給電回路により発生した高周波電力を前記真空製膜室の外部に位置する外部ケーブルから、前記真空製膜室の内部に位置する内部ケーブルを介して、前記放電電極に備えられた複数の給電点へ給電し、前記放電電極と前記基板との間にプラズマを発生させて、前記物質を前記基板上に蒸着させるプラズマ化学蒸着装置であって、高周波電力の前記複数の給電点における位相差の調整部として前記外部ケーブルの比誘電率を変化させたことを特徴とする。

このような装置とすることで、外部ケーブルの絶縁体操作によって、内部ケーブルを含む真空製膜室内部の構成機器の調整作業を伴わずに、高周波電力の複数の放電電極における位相の調整ができる。

すなわち、外部ケーブルの調整によって、放電電極に給電される高周波電力の波長、位相を変更・調整することができ、基板上に生成される薄膜の膜厚分布を均一化することができる。

図面の簡単な説明

図 1 は、本発明の一実施形態を実現するプラズマ化学蒸着装置の主要部を示すブロック図である。

図 2 は、本発明の一実施形態を実現するプラズマ化学蒸着装置に配設される外部ケーブルの構成図である。

図 3 は、本発明の一実施形態を実現するプラズマ化学蒸着装置に配設される内部ケーブルの構成図である。

発明を実施するための最良の形態

次に、本発明の実施形態について、図面を参照して説明する。

図 1 は、本発明の第 1 の実施形態のプラズマ化学蒸着方法を実施するプラズマ化学蒸着装置の主要部の構成を示すブロック図である。

図1において、符号10は、本実施の形態のプラズマ化学蒸着装置の真空製膜室であって、真空製膜室10内には、放電電極として用意されたラダー電極11と、ラダー電極11と所定の間隔をもって対面配置され、かつ接地されているアース電極（図示せず）と、該アース電極により保持された基板12とが備えられている。

また、真空製膜室10には、基板12への蒸着を希望するアモルファスシリコンや多結晶薄膜シリコン等の物質を含む製膜用ガスを導入するためのガス供給管13と、プラズマによる分解後のガスを排気するためのガス排気管14とが備えられている。また、真空製膜室10は、図示しないガス供給源からガス供給管13を介して製膜用ガスが供給されると共に、図示しない真空ポンプにより、ガス排気管14を介してプラズマによる分解後のガスが吸引される構成をなしている。

ラダー電極11は、平行な複数本の縦方向電極棒11aと、この縦方向電極棒11aに平行に対面配置された一対の横方向電極棒11b、11cとが格子状に組み立てられて構成されている。ラダー電極11を構成する横方向電極棒11bには例えば8つの給電点15a～15hが設けられ、同様にラダー電極11を構成する横方向電極棒11cにも8つの給電点16a～16hが設けられている。なお、各給電点15a～15h、及び各給電点16a～16hは、それぞれ横方向電極棒11b、11cをほぼ9等分する位置にそれぞれ設けられている。

なお、基板12が例えば1100 [mm] × 1400 [mm] 角サイズである場合は、ラダー電極11は、1200 [mm] × 1500 [mm] 角サイズ程度の基板12よりも一回り大きなサイズのものを利用する。

また、製膜用ガスを分解するためのプラズマを発生させる高周波電力をラダー電極11内の給電点15a～15hへ給電するために、真空製膜室10の外部に配置された電力分配器17Aの出力端子17a～17hと真空製膜室10の外壁に配設されたコネクタ18a～18hとが配設されている。

さらに、各出力端子17a～17hと各コネクタ18a～18hとをそれぞれ接続する外部ケーブルとして、導体の周囲に絶縁体を有する代表的なケーブルである8本の同軸（外部）ケーブル19a～19hと、各給電点15a～15hと

各コネクタ 18 a ~ 18 h とを真空製膜室 10 の内部でそれぞれ接続する 8 本の真空（内部）ケーブル 20 a ~ 20 h とを備える。

ここで、電力分配器 17 A は、高周波電源 21 a の出力する高周波電力を均等に給電点 15 a ~ 15 h へ分配するための分配器として備えられている。この電力分配器 17 A の入力端子は、効率よく高周波電力が供給されるように電力分配器 17 A と高周波電源 21 a との間のインピーダンス整合を調整するためのマッチングボックス 22 a を介して、高周波電源 21 a へ接続されている。

同様に、給電点 16 a ~ 16 h には、真空製膜室 10 の外部に配置された電力分配器 17 B の出力端子 17 i ~ 17 p と真空製膜室 10 の外壁に配設されたコネクタ 23 a ~ 23 h とが配設されている。各出力端子 17 i ~ 17 p と各コネクタ 23 a ~ 23 h とは、8 本の同軸ケーブル 24 a ~ 24 h でそれぞれ接続され、各給電点 16 a ~ 16 h とコネクタ 23 a ~ 23 h とは、8 本の真空ケーブル 25 a ~ 25 h によってそれぞれ接続されている。また、電力分配器 17 B の入力端子は、マッチングボックス 22 b を介して、高周波電源 21 b へ接続されている。

ここで電力分配器 17 B は、電力分配器 17 A と同様に、高周波電源 21 b の出力する高周波電力を均等に給電点 16 a ~ 16 h へ分配するための分配器である。また、マッチングボックス 22 b は、マッチングボックス 22 a と同様に、効率よく高周波電力が供給されるように電力分配器 17 B と高周波電源 21 b との間のインピーダンス整合を調整するために用いられる。

上述のラダー電極 11 と、同軸ケーブル 19 a ~ 19 h 及び 24 a ~ 24 h と、真空ケーブル 20 a ~ 20 h 及び 25 a ~ 25 h と、電力分配器 17 A、17 B と、高周波電源 21 a、21 b と、マッチングボックス 22 a、22 b とは、本実施の形態のプラズマ化学蒸着装置の高周波電力給電回路 26 を構成している。

図 2 に示す同軸ケーブル 19 a ~ 19 h 及び 24 a ~ 24 h は、一方向に延伸する心線（導体）27 と、心線 27 を連続して覆う絶縁体 28 と、さらに絶縁体 28 を連続して覆う金属網 29 と、これらを最外周から連続して覆う被覆 30 とから構成されている。

図 3 に示す真空ケーブル 20 a ~ 20 h 及び 25 a ~ 25 h は、一方向に延伸する撚り線状の心線 31 と、心線 31 の表面を隙間なきように互いに隣接して覆う複数個からなる碍子 32 と、これらを最外周から連続して覆う金属網 33 とから構成されている。

5 このような構成により、本実施の形態のプラズマ化学蒸着装置では、真空状態にした真空製膜室 10 内に、ガス供給管 13 から例えばアモルファスシリコンを含む製膜用ガスを導入すると共に、例えば、周波数 60.0 MHz の高周波 (VHF) 電力が、高周波電源 21 a からマッチングボックス 22 a と電力分配器 17 A とを介して均等に給電点 15 a ~ 15 h へ分配され、ラダー電極 11 へ
10 給電される。

一方、高周波電源 21 b から位相が異なる周波数 60.0 MHz の高周波 (VHF) 電力がマッチングボックス 22 b と電力分配器 17 B とを介して均等に給電点 16 a ~ 16 h へ分配され、ラダー電極 11 へ給電される。この時、高周波電源 21 a 及び高周波電源 21 b から供給される全電力は、例えば 3000
15 W となるように調整される。

そして、上記の状態で 10 分間程度、ラダー電極 11 と基板 12 との間にプラズマを発生させると、プラズマ中でアモルファスシリコンを含む製膜用ガスが分解され、ガス排気管 14 からプラズマによる分解後のガスを排気しながら、基板 12 の表面に希望のアモルファスシリコンの結晶が生成される。また、この時、
20 周波数が同一で一方の高周波電力の位相を基準として、他方の高周波電力の位相を一定の周波数をもって変化させた 2 つの高周波電力をラダー電極 11 に供給することにより、膜厚の均一化の妨げとなるラダー電極 11 上の定在波の発生を抑制し、電圧分布を均一化することによって給電方向の膜厚分布の均一化が促進される。

25 次に、本実施の形態のプラズマ化学蒸着装置において、上述のように物質を基板 12 に蒸着させる際に、同軸ケーブル 19 a ~ 19 h 及び 24 a ~ 24 h によって膜厚分布を均一化するプラズマ化学蒸着方法について説明する。

同軸ケーブル 19 a ~ 19 h 及び 24 a ~ 24 h は、絶縁体 28 の材質として従来の J I S - C - 3 5 0 1 により規格化されたポリエチレンとは異なり、ポリ

テトラフルオロエチレンを使用して、絶縁特性、寸法特性、及び操作性を向上させている。

また、真空ケーブル 20 a ~ 20 h 及び 25 a ~ 25 h は、撚り線状の心線 31 が延在する方向に所定の長さ寸法を有する複数個のアルミナから形成された碍子 32 が、心線 31 の表面を連続的に隙間のないよう配設されて構成されている。

上記各ケーブルは、それぞれ一定の寸法をもって真空製膜室 10 に配設されている。

一般に、絶縁体の比誘電率を ϵ 、比透磁率を μ 、光速度を c 、高周波電力の周波数を f とするとケーブルを伝送する高周波電力の波長 λ は、下記 (1) 式により求めることができる。

$$\lambda = \frac{1}{\sqrt{\epsilon\mu}} \cdot \frac{c}{f} \dots\dots(1)$$

これによると、本実施の形態で使用される同軸ケーブル 19 a ~ 19 h 及び 24 a ~ 24 h では、伝送される高周波電力の波長は 3.45 m となることから、1 波長分のずれを 360° の位相差と換算すると、ケーブル長が 1 cm 異なると 1.04° 位相がずれることとなる。

一方、本実施の形態で使用される真空ケーブル 20 a ~ 20 h 及び 25 a ~ 25 h では、伝送される高周波電力の波長は 1.66 m となることから、上述と同様の換算によれば、ケーブル長が 1 cm 異なると 2.17° 位相がずれることとなる。

従って、ケーブル長の差が位相差に与える影響が小さいために位相差の微調整が可能となる同軸ケーブル 19 a ~ 19 h 及び 24 a ~ 24 h の長さ寸法を変更することによって高周波電力の位相が調整される。すなわち、大気ケーブルの方が真空ケーブルに比べて、1 cm 当たりの位相ずれが小さいので、位相の微調整がしやすい。

そこで、まず基準長さを有する同軸ケーブル 19 a ~ 19 h 及び 24 a ~ 24 h、真空ケーブル 20 a ~ 20 h 及び 25 a ~ 25 h を配設し、実際に高周波電

力を供給して基板 1 2 上に製膜させた後、膜厚等の蒸着状態を観察する。

観察結果に基づいて、調整すべき基板 1 2 上の箇所に対応する電極及び給電点に連通する同軸ケーブルの全長を変化させて再び配設し、先の操作と同様の高周波電力を供給して製膜させる。

- 5 上記操作を繰り返すことによって、基板上の製膜分布を均一化する。

例えば、同軸ケーブル 1 9 b、1 9 c、1 9 f、1 9 g の全長を他のケーブルよりも 1 0 0 mm 延長した場合（位相では約 11° の遅れに相当）、製膜速度が 1 0 % ~ 4 0 % の範囲で変化して、膜厚分布の偏差が $\pm 43.8\%$ から $\pm 39.6\%$ に改善される。

- 10 上記の方法によれば、基板上の製膜分布に基づく所定の外部ケーブルの長さ寸法を操作することによって、複数の給電点間に生じる高周波電力の位相差の発生を抑えて膜厚の分布特性を均一化する方法が提供できる。

15 なお、調整すべき同軸ケーブルの長さそのものは変化させずに、該当する同軸ケーブルが接続されているコネクタ 1 8 a ~ 1 8 h 及び 2 3 a ~ 2 3 h、出力端子 1 7 a ~ 1 7 p の何れか部分に各 1 以上の同様のコネクタを追加挿入しても、同軸ケーブルの長さ寸法を変化させることと同様の作用・効果を得ることができる。

20 また、(1) 式から、同軸ケーブルの絶縁体の比誘電率を例えば 4 倍に変更することによって、ケーブルを伝送される高周波電力の波長が $1/2$ 倍となることから、同軸ケーブルの長さ寸法を変化させなくても、伝送する高周波電力の波長が変化する。よって、ケーブル長 1 cm あたりに相当する位相差も $1/2$ 倍となることから、互いに異なる比誘電率を有する同軸ケーブルを配設することによっても、複数の給電点間に生じる電気的特性のばらつきを抑制することができ、上述と同様に膜厚の分布特性を均一化する方法が提供できる。

- 25 さらに、上記の高周波電力の波形は、三角波であっても、正弦波等であっても構わない。

請 求 の 範 囲

1. 物質を含む製膜用ガスが導入された真空製膜室内に、放電電極と基板とが対向配置され、高周波電力給電回路により発生した高周波電力を前記真空製膜室の外部に位置する複数の外部ケーブルから、前記真空製膜室の内部に位置するとともに、各前記外部ケーブルに対応する複数の内部ケーブルを介して、前記放電電極に備えられた複数の給電点へ給電し、前記放電電極と前記基板との間にプラズマを発生させて、前記物質を前記基板上に蒸着させるプラズマ化学蒸着方法であって、

前記外部ケーブルの電気的特性を変化させて前記複数の給電点へ給電される高周波電力の前記給電点における位相を調整することを特徴とするプラズマ化学蒸着方法。

2. 前記外部ケーブルの電気的特性を変化させて蒸着を行い、前記基板上における前記物質の蒸着状態を観察し、該観察結果に基づきさらに前記外部ケーブルの電気的特性を変化させて、前記複数の給電点へ給電される高周波電力の位相を調整することを特徴とする請求項1記載のプラズマ化学蒸着方法。

3. 前記外部ケーブルの長さを変化させることによって、前記電気的特性を変化させることを特徴とする請求項1又は2記載のプラズマ化学蒸着方法。

4. 前記外部ケーブルの長さを1以上のコネクタ脱着によって変化させることを特徴とする請求項3記載のプラズマ化学蒸着方法。

5. 前記外部ケーブルが導体の周囲に絶縁体を有する構成とされ、該絶縁体の比誘電率を変化させることによって、前記電気的特性を変化させることを特徴とする請求項1又は2記載のプラズマ化学蒸着方法。

6. 前記外部ケーブルの絶縁体がポリテトラフルオロエチレンであることを特徴とする請求項1～5記載のプラズマ化学蒸着方法。

7. 物質を含む製膜用ガスが導入された真空製膜室内に、放電電極と基板とが対向配置され、高周波電力給電回路により発生した高周波電力を前記真空製膜室の外部に位置する複数の外部ケーブルから、前記真空製膜室の内部に位置するとともに各前記外部ケーブルに対応する複数の内部ケーブルを介して、前記放電電極に備えられた複数の給電点へ給電し、前記放電電極と前記基板との間にプラズ

マを発生させて、前記物質を前記基板上に蒸着させるプラズマ化学蒸着装置であって、

高周波電力の前記複数の給電点における位相差を調整するように各前記外部ケーブルの長さを変化させたことを特徴とするプラズマ化学蒸着装置。

- 5 8. 物質を含む製膜用ガスが導入された真空製膜室内に、放電電極と基板とが対向配置され、高周波電力給電回路により発生した高周波電力を前記真空製膜室の外部に位置する複数の外部ケーブルから、前記真空製膜室の内部に位置するとともに、各前記外部ケーブルに対応する複数の内部ケーブルを介して、前記放電電極に備えられた複数の給電点へ給電し、前記放電電極と前記基板との間にプラ
- 10 ズマを発生させて、前記物質を前記基板上に蒸着させるプラズマ化学蒸着装置であって、

高周波電力の前記複数の給電点における位相差を調整するように各前記外部ケーブルの比誘電率を変化させたことを特徴とするプラズマ化学蒸着装置。

図 1

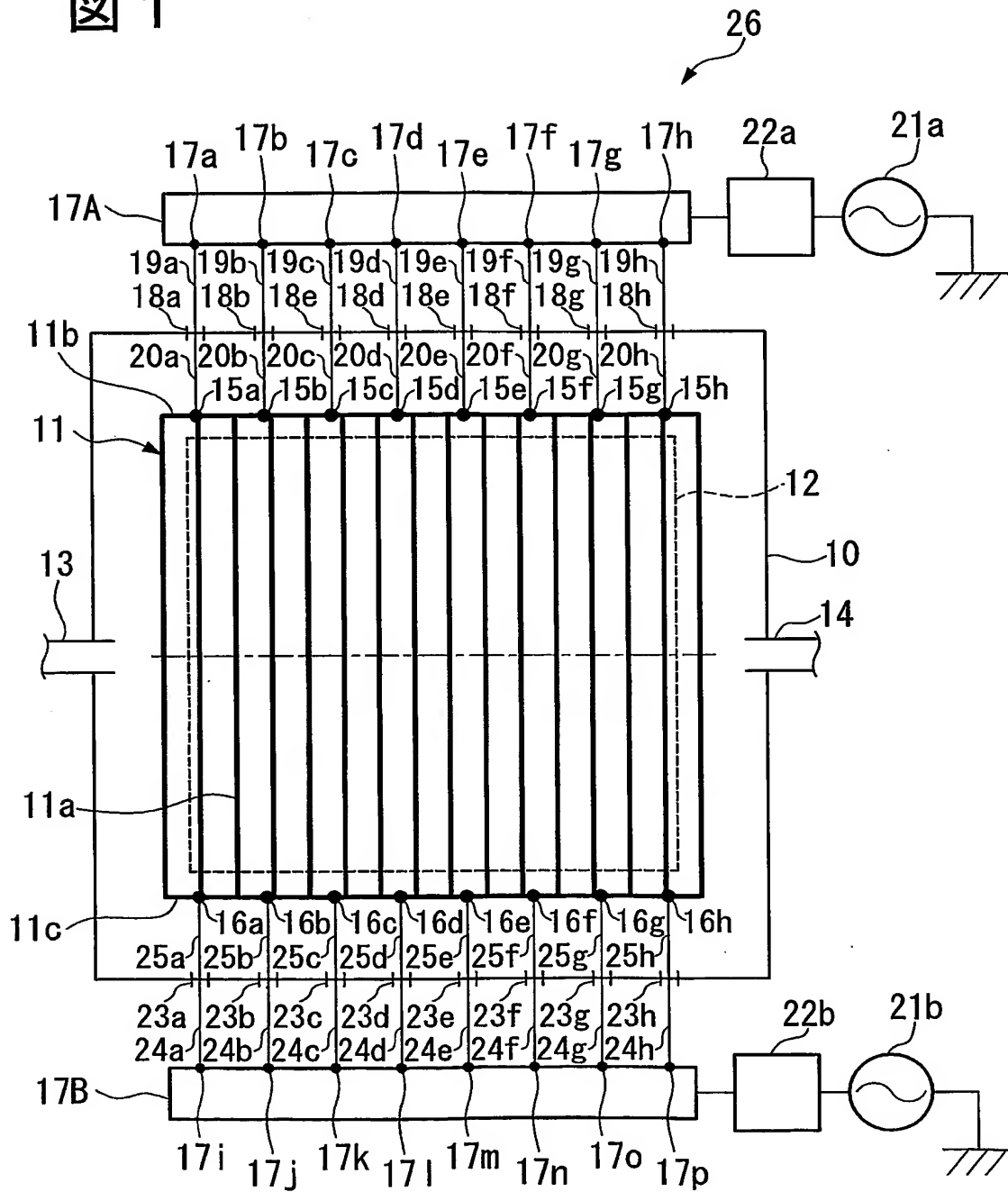


図 2

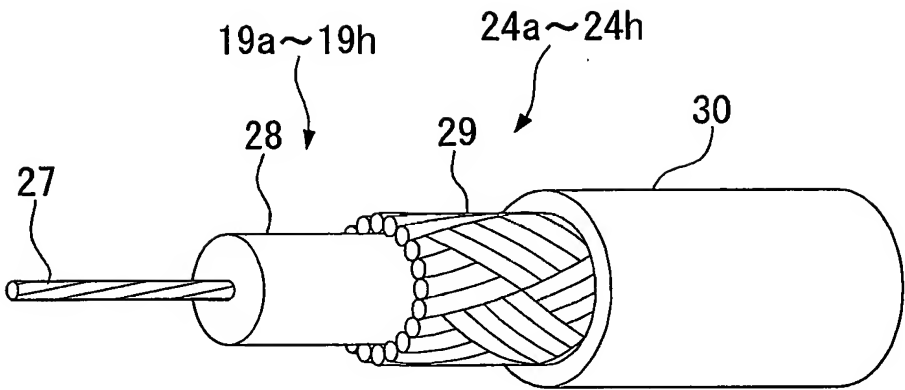
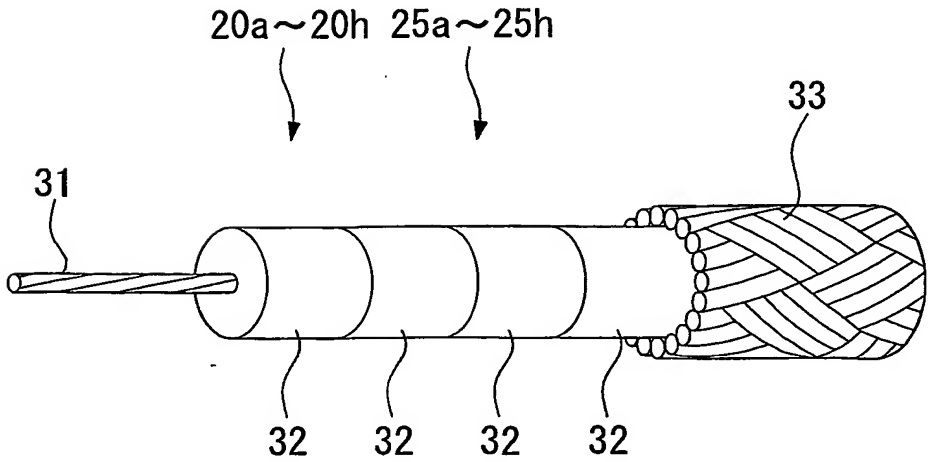


図 3



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP03/13821

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl⁷ H01L21/205

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl⁷ H01L21/205

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1926-1996	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2004
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2004	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2004

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 2001-257098 A (Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.), 21 September, 2001 (21.09.01), Full text & US 6456010 B2 & AU 75192 B & JP 3316490 B2 & JP 3377773 B2 & KR 2001-91880 A & TW 507256 A	1-8

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier document but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
03 February, 2004 (03.02.04)

Date of mailing of the international search report
24 February, 2004 (24.02.04)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ H 0 1 L 2 1 / 2 0 5

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ H 0 1 L 2 1 / 2 0 5

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1926-1996年

日本国公開実用新案公報 1971-2004年

日本国登録実用新案公報 1994-2004年

日本国実用新案登録公報 1996-2004年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	J P 2 0 0 1 - 2 5 7 0 9 8 A (三菱重工業株式会社), 2 0 0 1. 0 9. 2 1, 全文 & US 6 4 5 6 0 1 0 B 2, & AU 7 5 1 9 2 B, & J P 3 3 1 6 4 9 0 B 2, & J P 3 3 7 7 7 3 B 2, & KR 2 0 0 1 - 9 1 8 8 0 A, TW 5 0 7 2 5 6 A	1 - 8

☐ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの

「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの

「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)

「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献

「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

0 3 . 0 2 . 0 4

国際調査報告の発送日

24. 2. 2004

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/J P)

郵便番号 100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

田代 吉成

4 R

9 4 4 8

電話番号 03-3581-1101 内線 3470